

. Остающиеся небольшие расхождения между теорией и экспериментом можно устранить, если при расчетах влияние зазоров учитывать не только как отсутствие в них фотогенерации носителей, а рассматривать и обусловленное ими ослабление полей рассеяния вследствие уменьшения в них диэлектрической проницаемости.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Бонч-Бруевич В. Л., Калашников С. Г. Физика полупроводников. М., 1977. 672 с.
- [2] Винокуров Л. А., Фукс Б. И. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 11. С. 1986—1993.
- [3] Milton A. F. // Appl. Phys. Lett. 1970. V. 16. N 7. P. 285—287.
- [4] Сурис Р. А., Фукс Б. И. // ФТП. 1978. Т. 12. В. 12. С. 2319—2327.
- [5] Фукс Б. И. // ФТП. 1981. Т. 15. В. 9. С. 1679—1700.

Институт радиотехники и электроники  
РАН  
Москва

Получено 19.09.1991  
Принята к печати 5.12.1991

ФТП, том 26, вып. 4, 1992

## ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ИОНИЗАЦИИ ПРИМЕСЕЙ НА ПРОВОДИМОСТЬ СВЕРХРЕШЕТКИ В НЕМОНОХРОМАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Крючков С. В., Сырдоев Г. А.

Высокочастотная (ВЧ) проводимость полупроводниковой сверхрешетки (СР) исследовалась в ряде работ (см., например, [1] и ссылки к ней). Были предсказаны эффекты самоиндукционной прозрачности [2] и абсолютной отрицательной проводимости [3]. Однако во всех этих работах предполагалось, что концентрация носителей в минизоне проводимости  $n$  не зависит от величины напряженности ВЧ электрического поля. Кроме того, само поле предполагалось монохроматическим:  $E(t) = E_0 \cos(\omega t)$ ,  $E_0 \parallel OX$  — ось СР.

Вместе с тем, согласно [4], следует ожидать, что достаточно сильное электрическое поле будет вызывать ионизацию примесных центров даже при  $\omega \ll V_0$  ( $V_0$  — глубина залегания примеси,  $\hbar = 1$ ), изменяя тем самым концентрацию носителей тока. Немонохроматичность реального поля сводится не только к конечной ширине спектра излучения  $\Delta\omega$  ( $\Delta\omega \ll \omega$ ), но и к флюктуациям интенсивности ВЧ поля, что должно приводить к увеличению вероятности ионизации [5].

В настоящем сообщении предпринята попытка количественного учета процессов ионизации примесей на проводимость СР в немонохроматическом поле. Будем считать, что немонохроматическое поле удовлетворяет соотношению

$$\Delta\omega t_0 \ll 1 \quad (1)$$

( $t_0$  — так называемое «время туннелирования» электрона с примесного уровня в минизону проводимости). В этом случае флюктуации интенсивности имеют квазистатический характер и можно пренебречь затуханием корреляционных функций поля [5, 6]. При этом можно вычислить плотность электрического тока для монохроматического поля с заданным значением амплитуды  $E_0$ , усреднив окончательное выражение по флюктуациям  $E_0$ .

Будем исходить из классического кинетического уравнения с модельным интегралом столкновений в форме Батнагара—Гросса—Крука, так как именно такой член столкновений адекватно описывает ситуацию, при которой число носителей в минизоне отличается от равновесного значения. В правой части данного уравнения мы запишем также член генерации неравновесных носителей, соответствующий процессу ионизации примесных центров. Кроме того, учитываем процессы рекомбинации; для простоты ограничимся случаем постоянной частоты рекомбинации  $\nu_r$  [8].

Таким образом,

$$\frac{\partial f}{\partial t} + eE(t) \frac{\partial f}{\partial p_x} = -\nu \left( f - \frac{n}{n_0} f_0 \right) + G(p) - \nu_r (f - f_0). \quad (2)$$

Здесь  $f_0$  — равновесная функция распределения,  $G(p)$  задает число переходов электронов в единицу времени с примесных центров единицы объема в состояние с квазимпульсом  $p$ ; эта величина определяется вероятностью ионизации примесного центра и при  $E = 0$   $G(p) = 0$ .

Выполняя суммирование по  $p$  в обеих частях уравнения (2), получаем следующее уравнение непрерывности:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \sum_p G(p) - \nu_r (n - n_0). \quad (3)$$

В стационарном режиме из (3) следует, что полное (эффективное) число носителей в минизоне задается следующим соотношением:

$$n = n_0 + \nu_r^{-1} \sum_p G(p). \quad (4)$$

Именно эта величина  $n$  определяет ВЧ проводимость СР с учетом процессов ионизации. Подставляя (4) в (2) и проделывая соответствующие выкладки, получаем выражение для плотности тока в виде разложения в ряд Фурье

$$j_x = \sum_{k=-\infty}^{\infty} j_x^{(k)} \exp(ik\omega t), \quad (5)$$

где фурье-компоненты  $j_x^{(k)}$  имеют вид

$$j_x^{(k)} = \frac{j_0 n}{2n_0} \sum_{s=-\infty}^{\infty} [1 - (-1)^k] \frac{J_s(a) J_{k+s}(a)}{sw\nu^{-1} + 1}, \quad (6)$$

$$j_0 = \frac{\sigma_0 \nu}{ed}, \quad \sigma_0 = e^2 n_0 \Delta d^2 \nu^{-1} I_1 / I_0, \quad a = \frac{eE_0 d}{\omega} = \frac{\omega_{st}}{\omega}, \quad (7)$$

где  $I_k = I_k(\Delta/k_0 T)$  — модифицированная функция Бесселя,  $\Delta$  — полуширина минизоны.

Наиболее просто выглядит первая гармоника диссипативной составляющей плотности тока в приближении  $\omega \gg \nu$ :

$$f_x^{(1)} = \sigma(\omega) E_0 \cos(\omega t), \quad (8)$$

$$\sigma(\omega) = \sigma_0 \frac{n}{n_0} \left( \frac{\nu}{\omega} \right)^2 \left\{ \frac{2}{a^2} [1 - J_0^2(a)] \right\}. \quad (9)$$

Эффективная концентрация носителей  $n$  может быть выражена через вероятность ионизации примесного центра  $W$ , вычисленную в [7]:

$$n = n_0 (1 + N\nu_r^{-1} W / (n_0 t_0)). \quad (10)$$

Здесь

$$W = \exp(-Q), \quad (11)$$

$$Q = \frac{2V_0}{\omega} \left[ (1 + \delta) x_0 - \delta \int_0^{x_0} \operatorname{ch}(a \operatorname{sh}(x)) dx \right], \quad (12)$$

$$x_0 = \operatorname{Arsh} \left\{ a^{-1} \operatorname{Arsh} \left[ \frac{(2\delta + 1)^{1/2}}{\delta} \right] \right\}, \quad \delta = \Delta/V_0. \quad (13)$$

Выражение (8) для  $f_x^{(1)}$  следует теперь усреднить по флюктуациям  $E_0$ . Предполагая, что распределение вероятности данного значения  $E_0$  описывается известным распределением для теплового источника [5, 6], запишем усредненное по флюктуациям интенсивности выражение для плотности тока

$$\langle f_x^{(1)} \rangle = \frac{2}{\langle E^2 \rangle} \int_0^\infty f_x^{(1)}(E_0) \exp(-E_0^2/\langle E^2 \rangle) E_0 dE_0. \quad (14)$$

Здесь  $\langle E^2 \rangle = \frac{8\pi\omega}{c} \langle F \rangle$ ,  $\langle F \rangle$  — среднее значение интенсивности переменного поля.

Подставляя (8) в (14), получим

$$\langle f_x^{(1)} \rangle = j_0 \Phi \cos(\omega t), \quad (15)$$

$$\Phi = \frac{2(\pi\alpha)^{1/2}\nu}{\omega} \left[ \psi_1(\alpha) + \frac{N}{n_0} (\omega\nu_r^{-1}) \psi_2(\alpha) \right],$$

где введены следующие обозначения:

$$\psi_1(\alpha) = -1 - 2(\alpha/\pi)^{1/2} \int_0^\infty J_0^2(x) \exp(-\alpha x^2) dx, \quad (16)$$

$$\psi_2(\alpha) = 2(\alpha/\pi)^{1/2} \int_0^\infty \frac{W}{x_0} \{1 - J_0^2(x)\} \exp(-\alpha x^2) dx, \quad (17)$$

$$\alpha = \left( \frac{\omega}{ed} \right)^2 \frac{1}{\langle E^2 \rangle} = \frac{\omega^2}{\langle \omega_{st}^2 \rangle}. \quad (18)$$

Интеграл в формуле (16) выражается через обобщенный гипергеометрический ряд  ${}_2F_2$  следующим образом:

$$B = \int_0^\infty J_0^2 \exp(-\alpha x^2) dx = \frac{1}{2} (\alpha/\pi)^{1/2} {}_2F_2(1/2, 1/2; 1, 1; -1/\alpha) = \\ = (4\pi\alpha)^{-1/2} \sum_{k=0}^\infty [\Gamma(k + 1/2)]^2 (-1)^k (k!)^{-3} \alpha^{-k}. \quad (19)$$

В частности, при  $\alpha \gg 1$

$${}_2F_2(1/2, 1/2; 1, 1; -1/\alpha) = 1 \text{ и } B = (\pi/4\alpha)^{1/2}. \quad (20)$$

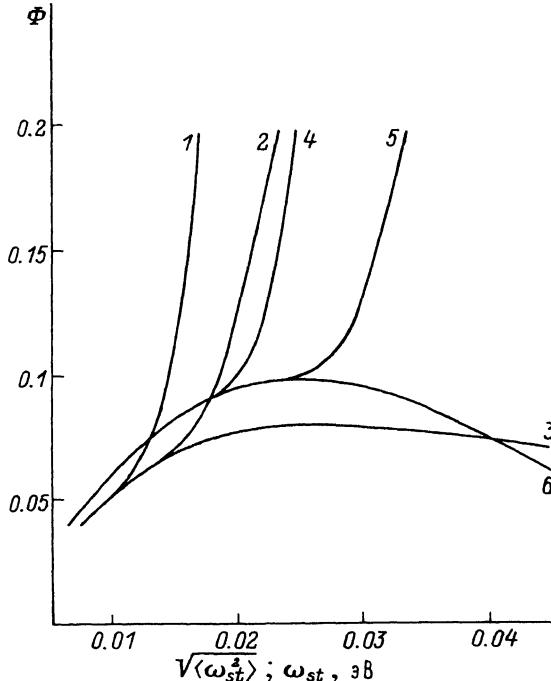
Этот результат очевиден заранее, так как при  $\alpha \gg 1$  в  $B$  дают вклад в основном такие значения  $x$ , для которых

$$x < \alpha^{-1} \ll 1 \text{ и } J_0(x) \approx 1. \quad (21)$$

Интеграл в (17) в квазиклассической ситуации может быть вычислен по методу перевала, при этом получается достаточно громоздкое выражение. Гораздо удобнее табулировать интегралы (16) и (17) численно, используя их первоначальные определения.

На рисунке представлены графики зависимости  $\Phi$  в немонохроматическом поле (1—3) от  $\langle \omega_{st}^2 \rangle$  и в монохроматическом поле (4—6) от  $\omega_{st}^2 = \langle \omega_{st}^2 \rangle$ . Глубины залеганий примеси для кривых (1, 4) равны между собой и по величине меньше, чем глубины для кривых (2, 5), которые также равны друг другу. Кривые 3 и 6 соответствуют случаю  $N=0$ . Из графиков видно, что учет процессов ионизации примесей приводит к экспоненциальному росту плотности тока в области сильных полей; получается типичная  $N$ -образная ВАХ. Усреднение по флуктуациям  $E_0$  в области малых значений  $\langle E^2 \rangle$  (в этом случае ионизация маловероятна) приводит к уменьшению  $\langle f_x^{(1)} \rangle$  по сравнению с  $f_x^{(1)}$ . При достаточно больших значениях  $\langle E^2 \rangle$  немонохроматическое поле увеличивает вероятность ионизации, что в свою очередь приводит к более сильному росту  $\langle f_x^{(1)} \rangle$ , чем  $f_x^{(1)}$ .

Благодарим Ф. Г. Басса за обсуждение работы и полезные замечания.



Зависимости  $\Phi$  от  $\{\langle \omega_{st}^2 \rangle\}^{1/2}$  для немонохроматического поля (1—3) и  $\Phi$  от  $\omega_{st} = \{\langle \omega_{st} \rangle\}^{1/2}$  для монохроматического поля (4—6).

$N, \text{ см}^{-3}$ : 1 —  $10^{16}$ , 2 —  $10^{16}$ , 3 — 0, 4 —  $10^{16}$ , 5 —  $10^{16}$ , 6 — 0.  $V_0, \text{ эВ}$ : 1 — 0.1, 2 — 0.12, 4 — 0.1, 5 — 0.12. Другие параметры:  $d = 123 \text{ \AA}$ ,  $\Delta = 0.05 \text{ эВ}$ ,  $\omega = 0.15 \text{ эВ}$ ,  $\omega/v = 10$ ,  $v_r = 10^{15} \text{ см}^{-1}$ ,  $n_0 = 10^{15} \text{ см}^{-3}$ .

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Bass F. G., Teterov A. P. // Phys. Reports. 1986. V. 140. N 5. P. 237.
- [2] Ignatov A. A., Romanov Yu. A. // Phys. St. Sol.(b). 1976. V. 73. P. 327—331.
- [3] Игнатов А. А., Романов Ю. А. // Изв. вузов СССР. Радиофизика, 1978. Т. 21. В. 1. С. 132.
- [4] Келдыш Л. В. // ЖЭТФ. 1964. Т. 47. В. 5(11). С. 1945—1957.
- [5] Далоне Н. Б. Взаимодействие лазерного излучения с веществом. М., 1989. 280 с.
- [6] Крайнов В. П., Тодирашку С. С. // ЖЭТФ. 1980. Т. 79. В. 1(7). С. 69—74.
- [7] Крючков С. В., Сыродеев Г. А. // ФТП. 1989. Т. 23. В. 5. С. 857—865.
- [8] Ландау Л. Д., Лицшиц Е. М. К теории фотоэлектродвижущей силы в полупроводниках // Ландау Л. В. Собрание трудов. Т. 1. С. 157—180.

Волгоградский педагогический институт

Получено 20.09.1991  
Принято к печати 5.12.1991

ФТП, том 26, вып. 4, 1992

#### ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАРЯДОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИМЕСИ ЕВРОПИЯ В РЕШЕТКЕ СЕЛЕНИДА СВИНЦА

Громовой Ю. С., Пляцко С. В., Кадышев С. К.

Возможность практического использования узкощелевых полупроводниковых соединений  $A^{IV}B^{VI}$  в качестве приемников, источников ИК излучения, а также